2020年3月26日

SSD で測定された Kr-84 のエネルギースペクトルと PHITS 計算の比較 ver.2

神原 正

2020 年 2 月 24 日-26 日に行われた M 社有償利用の際に測定された<sup>84</sup>Kr のエネルギースペ クトルを PHITS による Simulation と比較した。

使用したスペクトルは2月24日にSSDで測定されたデグレーダ厚さ依存性で、rawdataの ファイル名は scnEDssd1-0001.dmp から scnEDssd1-0022.dmp まで、デグレーダの厚さは 0 から 844.5 µ m まで、SSD は B1 と B2 である。

| 名称         | 材質                      | 厚さ        | 位置 (mm) |
|------------|-------------------------|-----------|---------|
| 散乱体        | 金                       | 45.8 μ m  | -130    |
| 真空切り窓      | カプトン                    | $78\mu$ m | 0       |
| 電離箱窓・電極とシン | マイラ                     | 89.4 μ m  | 30      |
| チの遮光幕(合計)  |                         |           |         |
| 電離箱電極      | アルミ                     | $14\mu$ m | 35      |
| シンチ        | プラスチックシンチ:              | 100 μ m   | 50      |
|            | EJ-212 Polyvinyltoluene |           |         |
| デグレーダ      | アルミ                     | 可変        | 145     |
| 大気         | 空気                      | 365mm-固体層 | 0-365   |
| 試料         | シリコン                    | 2.05mm    | 365     |
|            |                         |           | 1       |

PHITS 計算で設定した物質層を以下の表と図1に示す。厚さは cnfd サーバにあるエクセル ファイル①準備 ED 選 2002Kr(M01) 200226.xlsm の params シートの値に基づく。



図1:PHITS で設定したビームと物質層の配置。

散乱体に Kr-84 の平行ビームを入射して、デグレーダの厚さを変えながら Si 試料に入射 する Kr-84 イオンのエネルギー分布を[T-Cross]で計算した。

入射粒子のエネルギー分布は2種類設定した。すなわち 68MeV/A の単一エネルギー

[Source] proj = 84Kr # 入射粒子 e0 = 68 # energy of beam [MeV/u]

と 68MeV/A を中心とする半値全幅 0.36MeV/A のガウス分布で、ただし下限 67.64MeV/A から上限 68.36MeV/A の間に限定した。

[Source] # 入射粒子 proj = 84Kr # 入射エネルギー Gauss 分布 e-type 2 = eg0 = 68 # 中心值 [MeV/u] = 0.36 # 半値全幅 eg1 = 67.64 eg2 # カットオフ最小値 # カットオフ最大値 = 68.36 eg3

このビームエネルギー分布の中心値と幅の値は、計算結果が SSD の測定結果に一致するように選択した。入射粒子の個数は 20000 個とした。

それぞれのデグレーダ厚さに対して得られたエネルギースペクトルは、測定結果に対して はチャネル数、Simulation に対してはエネルギー (MeV/A) を変数 x として、高さ A、ピ ーク中心 $x_0$ 、幅  $\sigma$  をパラメータとするガウス関数

$$A \exp[-(x - x_0)^2 / 2\sigma^2]$$

で最小自乗近似した。

最小自乗近似の例として、デグレーダの厚さが446µmの場合に対するSSD-B1の測定と PHITSのSimulationで得られたピーク付近のスペクトルを図2に示す。左のグラフがSSD の測定結果、右のグラフがPHITSによる計算結果である。PHITS計算では入射粒子のエネ ルギー分布が単一エネルギーの場合とガウス分布の場合をともに示す。



Kr-84 energy peak at sample position after 648 µm-thick degrader

図 2: デグレーダ厚さ 648 µ m に対して SSD-B1 (左) と PHITS (右) で得られた Kr-84 のピーク付近のエネルギー分布。

PHITS の計算では、入射粒子を単一エネルギー分布からガウス分布にすると、ピーク位置 はほとんど変わらないがピーク幅は大きくなる。

最小自乗法で得られたピーク中心と幅の最適値をデグレーダ厚さの関数としてプロットし た結果を図 3 に示す。ただし左は SSD-B1 で右は SSD-B2 である。

それぞれ上の図はピーク中心位置で、赤丸が SSD によるチャンネル数で左の縦軸(Y 軸) が対応し、青丸が PHITS 計算によるエネルギー値(MeV/A)で右の縦軸(R 軸)が対応す る。ただし PHITS 計算の入射粒子エネルギー(あるいはその中心値)はビームの飛程が SSD 測定に合うように調整した。その結果が 68MeV/A である。またグラフの Y 軸と R 軸の尺 度の比は SSD の測定結果と PHITS の計算結果が重なるように調整した。その結果エネル ギーとチャネルの比は B1 で 0.01864、B2 で 0.0153 である。デグレーダの厚さによらずピ ーク位置は入射粒子のエネルギーが単一でもガウス分布でもほとんど同じである。

下の図はピーク幅σで、Y 軸と R 軸の尺度の比は上のピーク位置のグラフの値と同じであ る。入射粒子が単一エネルギーとした PHITS のピーク幅は測定結果の4分の1程度である が、エネルギーが半値全幅 0.36MeV/A のガウス分布になると仮定するとデグレーダの厚さ 全体にわたって測定値によく合う。



図 3:SSD-B1(左)と B2(右)のピーク中心(上)と幅(下)のデグレーダ厚さ依存 性と PHITS による計算結果の比較。